

Винахід належить до галузі одержання монокристалів напівпровідникових матеріалів, зокрема до підготовки тиглів для вирощування монокристалів кремнію з розплаву за методом Чохральського. Запропонований спосіб включає формування барієвмісного покриття з гідроксиду барію на внутрішній і/або зовнішній поверхні нагрітого до температури 100-150 °С кварцового тигля. Винахід дозволяє покращити рівномірність і однорідність покриття, що приводить до збільшення виходу придатного продукту і зниженню браку при одержанні злитків монокристалічного кремнію.